**ПРИЛОЖЕНИЕ Г**

**АВТОБИОГРАФИЯ**

Позиция по проекта:

|  |
| --- |
| Лична информация |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Име |  | **Александър Биков** |

|  |
| --- |
| Трудов стаж |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **•** Дати (от-до) |  | **1989 – ХФ при СУ’’Св.Климент Охридски’’** |
| **•** Име и адрес на работодателя |  | **СУ’’Св.Климент Охридски’’** |
| **•** Вид на дейността или сферата на работа |  | **Преподавател по Неорганична химия** |
| **•** Заемана длъжност |  | **гл. асистент** |
| **•** Основни дейности и отговорности |  | **Четене на лекции по Неорганична Химия на студенти от Физически и Геолого-Географски и Биологически факултети, както и водене на упражнения по Неорганична химия на студенти от Химически и Биологически факултет при СУ’’Св.Климент Охридски’’.** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **•** Дати (от-до) |  | **1986 -1989** |
| **•** Име и адрес на работодателя |  | **ИОНХ - БАН** |
| **•** Вид на дейността или сферата на работа |  | **Изседователска.** |
| **•** Заемана длъжност |  | **н.с. II ст.** |
| **•** Основни дейности и отговорности |  | **Изследване механизма на кристализация на сегнето – електрични кристали.** |

|  |
| --- |
| Образование и обучение |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| • Дати (от-до) |  | **2005 - 2008 – Международен сертификат на SISCO SYSTEMS за мрежов инжинер.** |
| • Име и вид на обучаващата или образователната организация |  | **„SISCO “SYSTEMS** |
| • Основни предмети/застъпени професионални умения |  | **Изграждане и управление на мрежи до 1000 поста.** |
| • Наименование на придобитата квалификация |  | **SISCO 640-802 CCNA**  |
| • Ниво по националната класификация (ако е приложимо) |  |  |

|  |
| --- |
| Образование и обучение |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| • Дати (от-до) |  | **1981 – 1986 – Аспирант**  |
| • Име и вид на обучаващата или образователната организация |  | **Физ. Фак. МГУ „М.В. Ломоносов“**  |
| • Основни предмети/застъпени професионални умения |  | **Физика на кристалите.** |
| • Наименование на придобитата квалификация |  | **Кандидат на физико-математическите науки; спец. Кристалография и Кристалофизика.** |
| • Ниво по националната класификация (ако е приложимо) |  | **Доктор** |

|  |
| --- |
| Образование и обучение |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| • Дати (от-до) |  | **1975 – 1980 - Магистър по Химия - Неорганик, Химически факултет,СУ’’Св.Климент Охридски’’** |
| • Име и вид на обучаващата или образователната организация |  | **Химически факултет,СУ’’Св.Климент Охридски’’** |
| • Основни предмети/застъпени професионални умения |  | **Физикохимия, тънки течни филми.** |
| • Наименование на придобитата квалификация |  | **Магистър** |
| • Ниво по националната класификация (ако е приложимо) |  | **Магистър** |

|  |  |
| --- | --- |
| Лични умения и компетенции Радиолюбител*Придобити в жизнения път или в професията, но не* непременно *удостоверени с официален документ или диплома.* |  |
| Майчин език |  | **Български** |

|  |
| --- |
| други езици  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  **Руски Английски Немски** |
| **•** Умения за четене |  | [Определете нива: отлично, добро, основно] |
| **•** Умения за писане |  | [Определете нива: отлично, добро, основно] |
| **•** Умения за разговор |  | [Определете нива: отлично, добро, основно] |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Социални умения и компетенции*Съвместно съжителство с други хора в мултикултурно обкръжение, в ситуации, в които комуникацията и екипната работа са от съществено значение (например в културата и спорта) и др.* |  | **Умения за работа в екип; СУ, МГУ и на други места.** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Организационни умения и компетенции*Координация и управление на хора, проекти и бюджети в професионалната среда, на доброволни начала (например в областта на културата и спорта) у дома и др.* |  | **Изпълнение на научно-изследователски проекти (1987 – 1991) с участие на различни лаборатории и хора.** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Технически умения и компетенции*Работа с компютри, със специфично оборудване, машини и др.* |  | **Виж по-горе.** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Артистични умения и компетенции*Музикални, писмени, дизайнерски и др.* |  | [Опишете тези компетенции и посочете къде са придобити.] |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Други умения и компетенции*Компетенции, които не са споменати по-горе.* |  | [Опишете тези компетенции и посочете къде са придобити.] |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Свидетелство за управление на МПС |  | **Да. От 1983г.** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Допълнителна информация |  | [Тук включете всякаква допълнителна информация, която може да е уместна, напр. лица за контакти, препоръки и др.] |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Приложения |  | [ Опишете всички приложения. ] |

ПУБЛИКАЦИИ И ДАКЛАДИ НА КОНФЕРЕНЦИИ

A.Z. Bikova,R.V.Genovaa,N.G.Vassilevb Influence of the spin-orientation of free and unpaired protons of ortho-water on the crystallization of the (001) face of TGS crystal: “in situ” investigation., Journal of Crystal Growth 395 (2014) 90–93.

a Department of Chemistry, University of Sofia, 1 J. Bourchier Boulevard, 1164 Sofia, Bulgaria

b Institute of Organic Chemistry, Bulgarian Academy of Sciences, Acad. G. Bonchev, Bulgaria

A.Z. Bikov, Activity of a growth center formed by more the two nonparallel dislocations at constant supersaturation and temperature., Current Topics in Crystal Growth Research, vol. 5 (1999), p. 194.

A.Z.Bikov, V.Ya.Nedkov, S.D. Stoichkov, Activity of a growth hill, generated by two crossed screw dislocations with equal Burgers’ vectors at constant supersaturation and temperature., Cryst. Res. Technol.34 (1999)p.1065.

A.Z.Bikov, S.D. Stoichkov, Activity of nonparallel center of growth of (001) face of TGS single srystal under inconstant conditions of crystallization", Cryst. Res. Technol., 32 (1997), p. 649.

A.Z.Bikov, S.D. Stoichkov, Change of the normal rate of hills growth on the (001) face of TGS single crystal under constant crystallization conditions., Cryst. Res. Technol.,32(1997)p.617.

A.Z.Bikov, Self-destruction of hills growth on the (001) face the TGS

single crystal., Cryst. Res. Technol.,30(1995)p.1111.

A.Z.Bikov, S.D. Stoichkov, S.B. Damianova, Distribution of the Gibbs activation energy for formation of a kink around the top of the growth hills of the (001) face of TGS single crystal., Cryst. Res. Technol.,29(1994)p.13.

A.Z.Bikov, V.G. Avramov, S.B. Damianova, S.D. Stoichkov, Adsorption of the Fe3+ ions on the (001) face of TGS single crystal; in situ investigation., Journal of Crystal Crowth 140 (1994)p.100.

A.Z.Bikov, Regeneration of(001), (110) and (101)faces of TGS single crystal and formation of dislocation growth centers. In situ investigations., Юб. Сб. 100 години Химически факултет, Май 1999 – София, стр.52.

А.З. Биков, Оптико-интерференционно изследване in situ формите на растеж и разтваряне на дислокационни центрове на стените (001), (110)и (101) на кристал от TGS.,Пловдив 1987г. (деп. В ЦИНТИ).

Доклади на конференции

 A.Z. Bikov, D.A. Coganov, J.W. Ponomarev, A.B. Saveliev, EXAFS spectroscopy with panoramic spectrum registration. Twelfth European crystallographic meeting, Moskow, 1989.

A.Z. Bikov, Composite dislocation sources of growth – morphology and kinetics. The Ninth International conference on crystal growth, August, 1989, Sendai, Japan.

 А.З. Биков, Оптико – интерференционное изследование регенерации граней (001),(110) и (101)кристалла ТГС. Юрата, ПНР, 1987л

 A.Z. Bikov, In situ optical interference study of the regeneration of (001), (110) and (101) faces of TGS single crystal. Formation of dislocation centers of growth. UPAC, Sofia,1986.

 А.З. Биков, А.А. Мкртчан, Ю.В. Пономарев, Л.Н. Рашкович,Топография растущей поверхности кристалла: рентгеновские и интерференционные наблюдения in situ. В Сб.: Тезисы докладов II Всесоюзнойконференции по физико-химическим основам технологии сегнетоелектрических и родственных материалов, Звенигород, 1983, с. 270.

 Ю.В. Пономарев, А.З. Биков, Рентгено-топографический и оптико - интерференционный спектрофотометер, Москва, МГУ, I Всес. Конф. По лазерной техники, разс. „Перспективные разработки”, 1983.